

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Yasuo YAMAGUCHI, et al.

GAU:

SERIAL NO: New Application

EXAMINER:

FILED: Herewith

FOR: ACCELERATION SENSOR

REQUEST FOR PRIORITY

COMMISSIONER FOR PATENTS  
ALEXANDRIA, VIRGINIA 22313

SIR:

☐ Full benefit of the filing date of U.S. Application Serial Number \_\_\_\_\_, filed \_\_\_\_\_, is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §120.

☐ Full benefit of the filing date(s) of U.S. Provisional Application(s) is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119(e):  
Application No. \_\_\_\_\_ Date Filed \_\_\_\_\_

☒ Applicants claim any right to priority from any earlier filed applications to which they may be entitled pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119, as noted below.

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicants claim as priority:

COUNTRY

Japan

APPLICATION NUMBER

2003-311066

MONTH/DAY/YEAR

September 3, 2003

Certified copies of the corresponding Convention Application(s)

☒ are submitted herewith

☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee

☐ were filed in prior application Serial No. \_\_\_\_\_ filed \_\_\_\_\_

☐ were submitted to the International Bureau in PCT Application Number \_\_\_\_\_

Receipt of the certified copies by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.

☐ (A) Application Serial No.(s) were filed in prior application Serial No. \_\_\_\_\_ filed \_\_\_\_\_; and

☐ (B) Application Serial No.(s) \_\_\_\_\_

☐ are submitted herewith

☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee

Respectfully Submitted,

OBLON, SPIVAK, McCLELLAND,  
MAIER & NEUSTADT, P.C.

  
C. Irvin McClelland

Registration No. 21,124

Customer Number

22850

Tel. (703) 413-3000  
Fax. (703) 413-2220  
(OSMMN 05/03)

James D. Hamilton  
Registration No. 28,421

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日            2 0 0 3 年   9 月   3 日  
Date of Application:

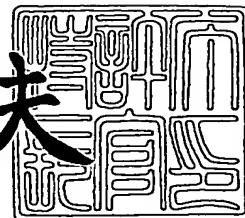
出 願 番 号            特 願 2 0 0 3 - 3 1 1 0 6 6  
Application Number:  
[ST. 10/C] :            [ J P 2 0 0 3 - 3 1 1 0 6 6 ]

出   願   人            三 菱 電 機 株 式 会 社  
Applicant(s):

2 0 0 3 年 1 0 月 3 1 日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

今 井 康 夫



【書類名】 特許願  
【整理番号】 546214JP01  
【提出日】 平成15年 9月 3日  
【あて先】 特許庁長官殿  
【国際特許分類】 G01P 15/00  
H01L 29/84

【発明者】  
【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内二丁目 2 番 3 号 三菱電機株式会社内  
【氏名】 山口 靖雄

【発明者】  
【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内二丁目 2 番 3 号 三菱電機株式会社内  
【氏名】 中村 邦宏

【特許出願人】  
【識別番号】 000006013  
【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内二丁目 2 番 3 号  
【氏名又は名称】 三菱電機株式会社

【代理人】  
【識別番号】 100086405  
【弁理士】  
【氏名又は名称】 河宮 治  
【電話番号】 06-6949-1261  
【ファクシミリ番号】 06-6949-0361

【選任した代理人】  
【識別番号】 100101454  
【弁理士】  
【氏名又は名称】 山田 卓二  
【電話番号】 06-6949-1261  
【ファクシミリ番号】 06-6949-0361

【手数料の表示】  
【予納台帳番号】 163028  
【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】  
【物件名】 特許請求の範囲 1  
【物件名】 明細書 1  
【物件名】 図面 1  
【物件名】 要約書 1

**【書類名】 特許請求の範囲****【請求項 1】**

基板と、  
基板上に配設された、加速度センサ素子および該センサ素子を囲む枠部と、  
枠部上に配設された中間層と、  
中間層と接合され、これにより加速度センサ素子を封止するキャップ部とを備え、  
枠部および中間層にはそれぞれ、基板主面方向に関し略同一の位置に枠状の溝が設けてあることを特徴とする加速度センサ。

**【請求項 2】**

枠部および中間層にそれぞれ設けた溝が貫通溝であることを特徴とする請求項 1 の加速度センサ。

**【請求項 3】**

キャップ部には、中間層との接合領域において、上記枠部および中間層の溝と基板主面方向に関し略同一の位置に溝が設けてあることを特徴とする請求項 1 または 2 の加速度センサ。

**【請求項 4】**

基板と、  
基板上に配設された、加速度センサ素子および該センサ素子を囲む枠部と、  
枠部上に配設された中間層と、  
中間層と接合され、これにより加速度センサ素子を封止するキャップ部とを備え、  
枠部は、中間層とキャップ部との接合領域よりも加速度センサ素子側に延在する延在部を有し、該延在部に加速度センサ素子を囲むように枠状の溝が設けてあることを特徴とする加速度センサ。

**【書類名】 明細書****【発明の名称】 加速度センサ****【技術分野】****【0001】**

本発明は加速度センサに関する。

**【背景技術】****【0002】**

従来、加速度センサ素子および該センサ素子を囲む枠部を半導体基板上に備え、キャップを枠部に接合することで加速度センサ素子を気密封止した加速度センサが知られている（例えば、特許文献1参照。）。

【特許文献1】 特開2002-134759号公報

**【発明の開示】****【発明が解決しようとする課題】****【0003】**

しかしながら、上記構成では、半導体基板上に加速度センサ素子および枠部がともに形成されているため、外力によるキャップと枠部の接合領域でのクラック、あるいは、接合領域でキャップと枠部の材料が異なる場合に両者の熱膨張係数の違いによって存在する残留応力が加速度センサ素子に伝播し易く、その結果、加速度センサの特性変動を引き起こすことがあった。

**【0004】**

そこで、本発明は、外力や残留応力によって特性変動の起きにくい加速度センサを提供することを目的とする。

**【課題を解決するための手段】****【0005】**

上記目的を達成するために、本発明に係る加速度センサの第1の態様は、  
基板と、  
基板上に配設された、加速度センサ素子および該センサ素子を囲む枠部と、  
枠部上に配設された中間層と、  
中間層と接合され、これにより加速度センサ素子を封止するキャップ部とを備え、  
枠部および中間層にはそれぞれ、基板主面方向に関し略同一の位置に枠状の溝が設けてあることを特徴とする。

**【0006】**

本発明に係る加速度センサの第2の態様は、  
基板と、  
基板上に配設された、加速度センサ素子および該センサ素子を囲む枠部と、  
枠部上に配設された中間層と、  
中間層と接合され、これにより加速度センサ素子を封止するキャップ部とを備え、  
枠部は、中間層とキャップ部との接合領域よりも加速度センサ素子側に延在する延在部を有し、該延在部に加速度センサ素子を囲むように枠状の溝が設けてあることを特徴とする。

**【発明の効果】****【0007】**

本発明に係る第1の態様によれば、中間層と枠部に枠状の溝を設けることで、外力によってキャップ部と枠部の接合領域でクラックが発生しても、溝でクラックの進行が止まるので、加速度センサの気密性が保たれ加速度センサ素子の特性変動は生じない。さらに、中間層と枠部の枠状溝の位置を基板主面方向に関し略同一に設定してあるので、加速度センサの基板主面方向に関する寸法の小型化を図ることができる。

**【0008】**

本発明に係る第2の態様によれば、枠部の延在部に加速度センサ素子を囲むように枠状の溝を設けることで、中間層とキャップ部との接合における残留応力が溝を超えて伝播す

ることがなく、したがって加速度センサ素子の特性変動を防止できる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0009】

以下、添付図面を参照して本発明に係る実施の形態を説明する。

【0010】

実施の形態 1.

図 1 は、本発明に係る加速度センサの実施の形態 1 を示す断面図である。この加速度センサ 2 は、加速度センサ素子 3 を載置するためのベース部 4 と、ベース部 4 と接合してセンサ素子 3 を気密封止するためのキャップ部 5 とを備える。

【0011】

図 2 に上面図を示すベース部 4 は、矩形状のシリコン半導体基板 6（広義には基板）を備え、該基板 6 の主面上には、加速度を検出するためのセンサ素子 3 と該センサ素子 3 を囲む枠部 8 とが設けてある。なお、枠部 8 は矩形状が一般的であるが、その形状は本発明を限定しない。加速度センサ素子 3 および枠部 8 は、例えば、半導体基板 6 上に、不純物としてリンがドーピングされたポリシリコン層を堆積した後、ポリシリコンをエッチングなどにより選択的に除去して形成される。ドーパントとして、リン以外に例えばガリウム、ボロン、ヒ素などでもよい。

【0012】

図 3（a）、（b）は、加速度センサ素子 3 を示す拡大図である。加速度センサ素子 3 は容量式の加速度センサ素子で、外力によって変位する重り部 10 を備える。重り部 10 は、半導体基板 6 主面と所定の間隔をあけて図 3（a）左右方向を長手方向、上下方向を短手方向とした略矩形状の可動電極 12 を有する。可動電極 12 は、各短辺から長手方向にそれぞれ突出した突出部 14 L、14 R、さらに短手方向に伸びた梁部 16 L、16 R を介して、半導体基板 6 主面上に固定された支持部 18 L、18 R に連結されている。梁部 16 L、16 R は、図 3（a）上下方向長さ比べて左右方向長さ（幅）が短く左右方向に関して僅かに伸縮可能で、その結果、加速度センサ 2 が左右方向に外力を受けた場合に、可動電極 12 が左右方向に変位できるようになっている。可動電極 12 には、各長辺中央からそれぞれ短手方向に伸びた所定の大きさの溝 20 U、20 D が形成されている。各溝 20 U、20 D 内にはそれぞれ、半導体基板 6 主面上に固定された固定電極 22 U、22 D が配置されている。加速度センサ 2 が外力を受けて固定電極 22 U と溝 20 U を形成する可動電極 12 部分内面の隙間および固定電極 22 D と溝 20 D を形成する可動電極 12 部分内面の隙間が変化することで、可動電極 12 と各固定電極 22 U、22 D の間の静電容量が変化する（上述したように、可動電極 12 および固定電極 22 U、22 D を形成するポリシリコンには、電氣的導通を図るためリンがドーピングされている。）。静電容量の変化は、電気信号として外部の容量計測回路（図示せず）に出力される。

【0013】

加速度センサ素子 3 の構成は本発明を限定するものではなく、例えば可動電極が半導体基板 6 の主面方向に垂直な方向に変位できるものでもよい。また、容量式に限らず、ピエゾ抵抗式でもよい。

【0014】

図 1、2 に戻って、枠部 8 上にはノンドープのポリシリコン層 24 が形成されている。ポリシリコン層 24 は、例えば CVD 法により成膜した例えばシリコン酸化膜で、枠部 8 を形成するポリシリコンに含まれるリンが拡散してポリシリコン層 24 とキャップ部 5 との接合界面に到達して析出することがないようにその厚みが設定されている。ポリシリコン層 24 は、枠部 8 とキャップ部 5 との間の中間層を構成する。枠部 8 とポリシリコン層 24 には、主面方向に関して略同一位置に枠状の貫通溝がそれぞれ形成され、全体として枠状の溝 25 を構成している。

【0015】

キャップ部 5 は、シリコンの矩形状半導体基板から例えばザグリ加工により凹部 26 が形成されたキャップ（本体）27 を備え、凹部 26 を形成する側の主面には金属層 28 が

形成されている。金属層 28 は、キャップ 27 に、例えばチタン膜、続いてニッケル膜を例えば蒸着やスパッタリングで形成する。チタン膜とニッケル膜の厚さは、ポリシリコン層 24 との間の接合の強さおよび膜形成に伴って生じる残留応力を考慮して、それぞれ数十 nm、数百 nm が適当である。

#### 【0016】

加速度センサ 2 の製造時、ベース部 4 のポリシリコン層 24 とキャップ部 5 の金属層 28 を重ね合わせる。この状態で、真空下あるいは不活性ガス下の加熱炉内にベース部 4 およびキャップ部 5 を入れ、400℃で数十分から数時間加熱する。その結果、ポリシリコン層 24 のポリシリコンと金属層 28 のニッケルとが共晶合金を形成し、ベース部 4 とキャップ部 5 の接合が行われる。このとき、ベース部 4 のドーピングされた枠部 8 と金属層 28 の間にはノンドープのポリシリコン層 24 が介在されているので、枠部 8 を形成するポリシリコンに含まれるリンは、ノンドープのポリシリコン層 24 に拡散してもポリシリコン層 4 と金属層 28 との接合界面にリンが到達して析出することはない。その結果、ベース部 4 とキャップ部 5 の接合不良を防止できる。

#### 【0017】

かかる構成を備えた加速度センサ 2 は、ベース部 4 とキャップ部 5 との接合領域が多層構造となっているために、外力の影響を受けやすい。例えば、加速度センサ 2 を金属フレーム（図示せず）上に熱を加えてダイボンドする場合、シリコン半導体基板 6 と金属フレームの接着となるため両者の熱膨張係数の差から生じる残留応力、ダイボンド工程後に加速度センサ 2 等を封止するためのモールド工程時には、モールド樹脂を射出する圧力、加速度センサ 2 を搭載したデバイスの完成後には、加速度センサ 2 が置かれる環境（例えば熱履歴や湿気）によるモールドやダイボンドの劣化に伴う応力の変化などが外力として挙げられる。

#### 【0018】

溝 25 を有さない従来の構成では、上記外力により接合領域の各層間（半導体基板 6 と枠部 8 の間および枠部 8 とポリシリコン層 24 の間）でクラックが発生して、気密封止が破れ、加速度センサ素子 3 の特性が変動する場合がある。また、クラックに到らなくても、応力が枠部 8 や半導体基板 6 を通じて加速度センサ素子 3 まで伝播し、加速度センサ素子 3 の特性変動を引き起こす可能性がある。

#### 【0019】

これに対し、本実施形態の構成では、外力によりクラックが生じた場合でも溝 25 でクラックの進行が止まるので、センサ 2 の気密性は保たれセンサ素子 3 の特性変動は生じない。応力もまた、溝 25 を超えて伝播しないので、センサ素子 3 の特性変動に影響を与えない。したがって、溝 25 を設けることで高信頼性の加速度センサ 2 を提供できる。

#### 【0020】

本実施形態ではまた、枠部 8 に設けた枠状の溝とポリシリコン層 24 に設けた枠状の溝は、互いに重なる位置に配設しているので、加速度センサ 2 の半導体基板 6 の主面方向に関する寸法の小型化を図ることができる。

#### 【0021】

実施の形態 2.

図 4 は、本発明に係る加速度センサの実施の形態 2 を示す部分拡大断面図である。以下の説明では、実施の形態 1 と同一または類似の構成要素は同一の符号または同一の符号に適当な添字を付して表す。

#### 【0022】

本実施形態に係る加速度センサ 30 において、半導体基板 6 の主面上には絶縁層 32 が形成されている。絶縁層 32 は、半導体基板 6 上に、例えばまずシリコン酸化膜、続いてシリコン窒化膜を例えば CVD 法を用いて形成する。加速度センサ素子 3 と枠部 8 はこの絶縁層 32 上に形成され、これらの間が電氣的に絶縁されている。

#### 【0023】

金属層 28 と枠部 8 の間には、実施の形態 1 のように所定の厚みのポリシリコン層 24

を介在させる代わりに、拡散防止層としての絶縁層 34 およびノンドープのポリシリコン層 36（これら層 34、36 が枠部 8 とキャップ部 5 の間の中間層を構成する。）を介在させる。このために、ベース部 4A の製造工程時、枠部 8 上に絶縁層 34 を例えば CVD 法により、続いてポリシリコン層 36 を例えばスパッタリングにより形成する。次に、ベース部 4A のポリシリコン層 36 とキャップ部 5 の金属層 28 を重ね合わせる。この状態で、実施の形態 1 と同様にして、ポリシリコン層 36 のポリシリコンと金属層 28 のニッケルとが共晶合金を形成するように加熱し、ベース部 4A とキャップ部 5 の接合を行わせる。ポリシリコン層 36 と枠部 8 の間には拡散防止層 34 が介在されているので、枠部 8 を形成するシリコンに含まれるリンがノンドープのポリシリコン層 36 に拡散してポリシリコン層 36 と金属層 28 の界面に析出するのを防止できる。

#### 【0024】

絶縁層 32、枠部 8、絶縁層 34、およびポリシリコン層 36 には、主面方向に関して略同一位置に枠状の貫通溝がそれぞれ形成され、全体として枠状の溝 38 を構成している。

#### 【0025】

かかる構成を備えた加速度センサ 30 は、ベース部 4A とキャップ部 5 の接合領域が多層構造となっているために外力の影響を受けやすいが、外力によりクラックが生じた場合でも溝 38 でクラックの進行が止まるので、加速度センサ 30 の気密性は保たれ加速度センサ素子 3 の特性変動は生じない。応力もまた、溝 38 を超えて伝播しないので、加速度センサ素子 3 の特性変動に影響を与えない。したがって、溝 38 を設けることで高信頼性の加速度センサ 30 を提供できる。

#### 【0026】

本実施形態ではまた、絶縁層 32、枠部 8、絶縁層 34、およびポリシリコン層 36 にそれぞれ設けた枠状の溝は、互いに重なる位置に配設しているので、加速度センサ 30 の半導体基板 6 の主面方向に関する寸法の小型化を図ることができる。

#### 【0027】

半導体基板 6 にも絶縁層 32、枠部 8、絶縁層 34、およびポリシリコン層 36 と主面方向に関して略同一位置に枠状の溝を形成し、これにより、各層 32、8、34、36 とともに枠状の溝 38 を構成するようにしてもよい。溝 38 が半導体基板 6 まで至る構成は、応力の伝播距離が絶縁層 32 まで溝を設けた場合より長くなり、したがって上述の応力の伝播を防止する効果を増すことができるだけでなく、絶縁層 32 と半導体基板 6 との間で発生し得るクラックの進行および応力の伝播を防止する効果を有する。

#### 【0028】

実施の形態 3.

図 5 は、本発明に係る加速度センサの実施の形態 3 を示す部分拡大断面図である。本実施形態に係る加速度センサ 40 は、実施の形態 2 の加速度センサ 30 の構成と類似しているが、ベース部 4 に溝 38 を設ける代わりに、キャップ本体 27B の接合領域に枠状の溝 42 を設ける。溝 42 は、凹部 26B と同一工程（例えばザグリ加工）で形成してもよいし、別工程（例えばエッチング）で形成してもよい。

#### 【0029】

応力はキャップ部 5B 側を伝播する場合もあるが、本実施形態のように溝 42 を設けることで、応力は溝 42 を超えて伝播しないので、センサ素子 3 の特性変動に影響を与えず、したがって高信頼性の加速度センサ 40 を提供できる。

#### 【0030】

実施の形態 4.

図 6 は、本発明に係る加速度センサの実施の形態 4 を示す断面図である。図 7 は、本実施形態に係る加速度センサ 50 のベース部 4C の上面図である。速度センサ 50 は、実施の形態 1 の加速度センサ 2 と類似の構成を有するが、ベース部とキャップ部との接合領域に溝 25 を設ける代わりに、接合領域よりも加速度センサ素子 3 側に延在した枠部 8C 部分（すなわち接合領域と加速度センサ素子 3 との間）に枠状の溝 52 を設けたものである。



。

## 【0031】

ベース部4Cとキャップ部5の接合においてポリシリコン層24と金属層28の材料（シリコンとニッケル）の熱膨張係数の差により生じる残留応力は、ポリシリコン層24と金属層28の接合端部54が最大となる。したがって、溝52を設けない場合、残留応力が枠部8C続いて半導体基板6を介して加速度センサ素子3に伝播し、該センサ素子3の特性変動が引き起こされる場合があるが、溝52を設けることで、応力は溝52を超えて伝播しないので、センサ素子3の特性変動に影響を与えず、したがって高信頼性の加速度センサ50を提供できる。

## 【0032】

半導体基板6にも枠部8Cの枠状溝52と主面方向に関して略同一位置に枠状の溝を形成してもよい。

## 【0033】

実施の形態5.

図8は、本発明に係る加速度センサの実施の形態5を示す断面図である。本実施形態に係る加速度センサ60は、実施の形態2の加速度センサ30と類似の構成を有するが、キャップ部とベース部との接合領域に溝38を設ける代わりに、接合領域よりも加速度センサ素子3側に延在した枠部8D部分および絶縁層32（すなわち接合領域と加速度センサ素子3との間）に枠状の溝62を設けたものである。

## 【0034】

キャップ部5の金属層28とベース部4Dのポリシリコン層36の接合においてニッケルとシリコンの熱膨張係数の差により生じる残留応力は、金属層28とポリシリコン層36の接合端部64が最大となる。したがって、溝62を設けない場合、残留応力がポリシリコン層36、絶縁層34、枠部8、絶縁層32、続いて半導体基板6を介して加速度センサ素子3に伝播し、該センサ素子3の特性変動が引き起こされる場合があるが、溝62を設けることで、応力は溝62を超えて伝播しないので、加速度センサ素子3の特性変動に影響を与えず、したがって高信頼性の加速度センサ60を提供できる。

## 【0035】

半導体基板6にも絶縁層32、枠部8Dと主面方向に関して略同一位置に枠状の溝を形成し、これにより、各層32、8Dとともに枠状の溝62を構成するようにしてもよい。

## 【0036】

実施の形態6.

図9は、本発明に係る加速度センサの実施の形態6を示す断面図である。本実施形態に係る加速度センサ70は、実施の形態2、3、5と同様の溝38E、42E、62Eを備えたものである。ベース部4Eの溝38Eとキャップ部5Eの溝42Eは、半導体基板6の主面方向に関して略同一位置に形成され、加速度センサ70の主面方向に関する寸法の小型化が図られている。

## 【0037】

溝62Eを設ければ、溝38E、42Eを設けなくても加速度センサ素子3への応力の伝播は防止できるが、溝38E、42Eは主としてクラックによって加速度センサ70の気密封止が破れるのを防止するためのものである。

## 【0038】

以上、本発明の具体的な実施形態を説明したが、本発明はこれらに限らず種々改変可能である。例えば、枠部および枠部-キャップ部間に配置される中間層（例えば、実施の形態1であればポリシリコン層24であり、実施の形態2であれば少なくとも絶縁層34を含む層）にそれぞれ形成する枠状の溝は、半導体基板主面方向に関して略同一の位置に配設するのであれば、連通していない場合（中間層に形成する枠状溝が貫通溝でない場合）も本発明の範囲内に含まれる。但し、別工程で作製したベース部とキャップ部を接合する点や溝の形成のし易さの点などを考慮して、中間層に形成する溝は、中間層とキャップ部との接合界面に開放されているのが好ましい。また、ベース部とキャップ部との接合領域

の各層間に発生し得るクラックや残留応力に対応するために、枠部および中間層の各溝は貫通溝であるのが好ましい。これは、溝の形成のし易さの点からも有利である。

【0039】

さらに、実施の形態 2, 6 において半導体基板に直に形成する絶縁層に溝を設けない構成も、本発明の範囲内に含まれる。

【0040】

加えて、中間層とキャップとの接合領域よりも内側に延在する部分に形成する枠状の溝は、貫通溝でない構成も本発明の範囲内に含まれる。

【図面の簡単な説明】

【0041】

【図 1】 本発明に係る加速度センサの実施の形態 1 を示す断面図。

【図 2】 図 1 のベース部を示す上面図。

【図 3】 (a) 図 1 の加速度センサ素子を示す上面図。(b) 図 3 (a) の I I I b 方向から見た加速度センサ素子の側面図。

【図 4】 本発明に係る加速度センサの実施の形態 2 を示す部分拡大断面図。

【図 5】 本発明に係る加速度センサの実施の形態 3 を示す部分拡大断面図。

【図 6】 本発明に係る加速度センサの実施の形態 4 を示す断面図。

【図 7】 図 6 のベース部を示す上面図。

【図 8】 本発明に係る加速度センサの実施の形態 5 を示す部分拡大断面図。

【図 9】 本発明に係る加速度センサの実施の形態 6 を示す部分拡大断面図。

【符号の説明】

【0042】

3 加速度センサ素子

4 A ベース部

5 キャップ部

6 半導体基板

8 枠部

28 金属層

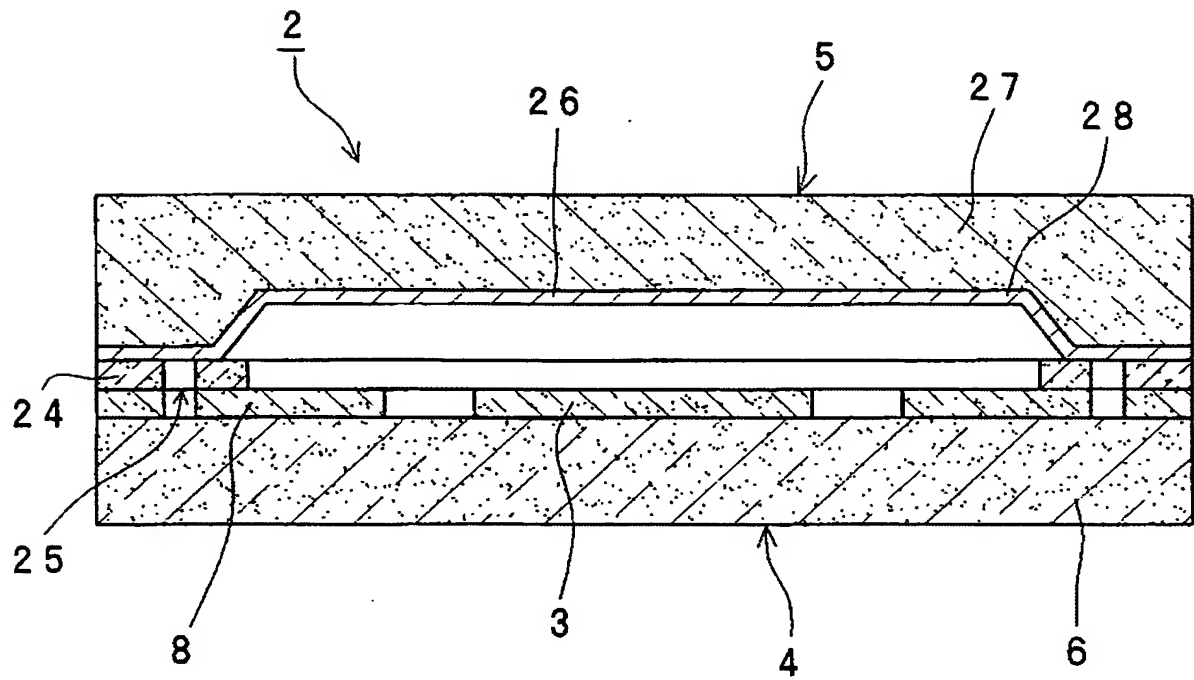
30 加速度センサ

34 絶縁層

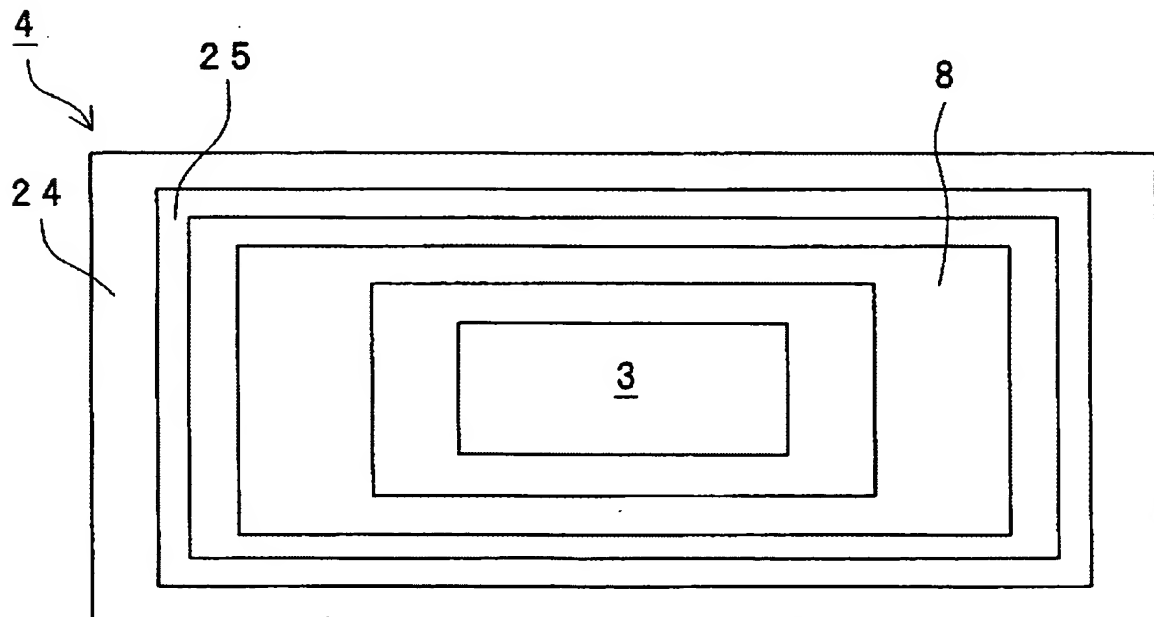
36 ノンドープのポリシリコン層

38 枠状の溝

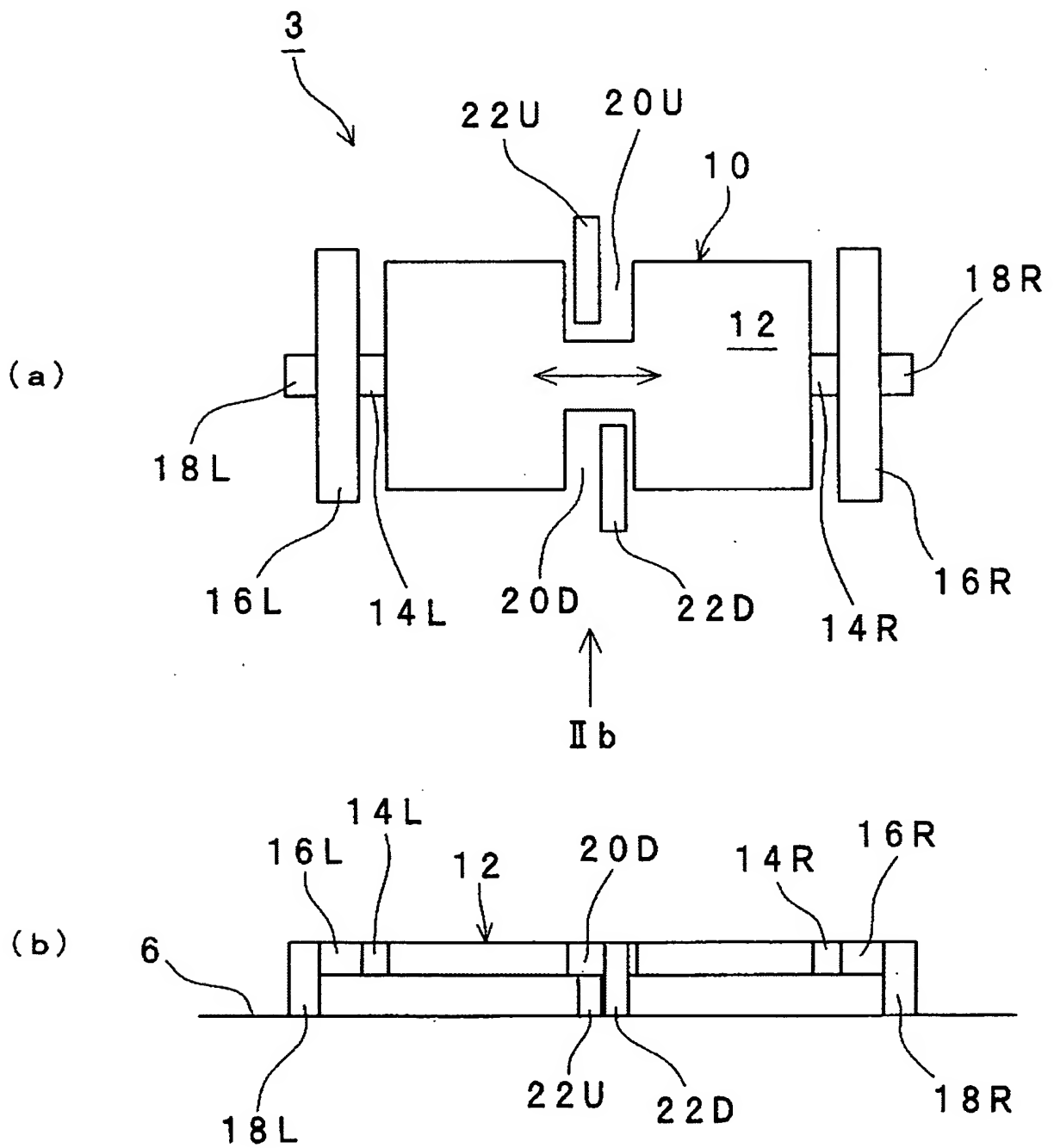
【書類名】 図面  
【図 1】



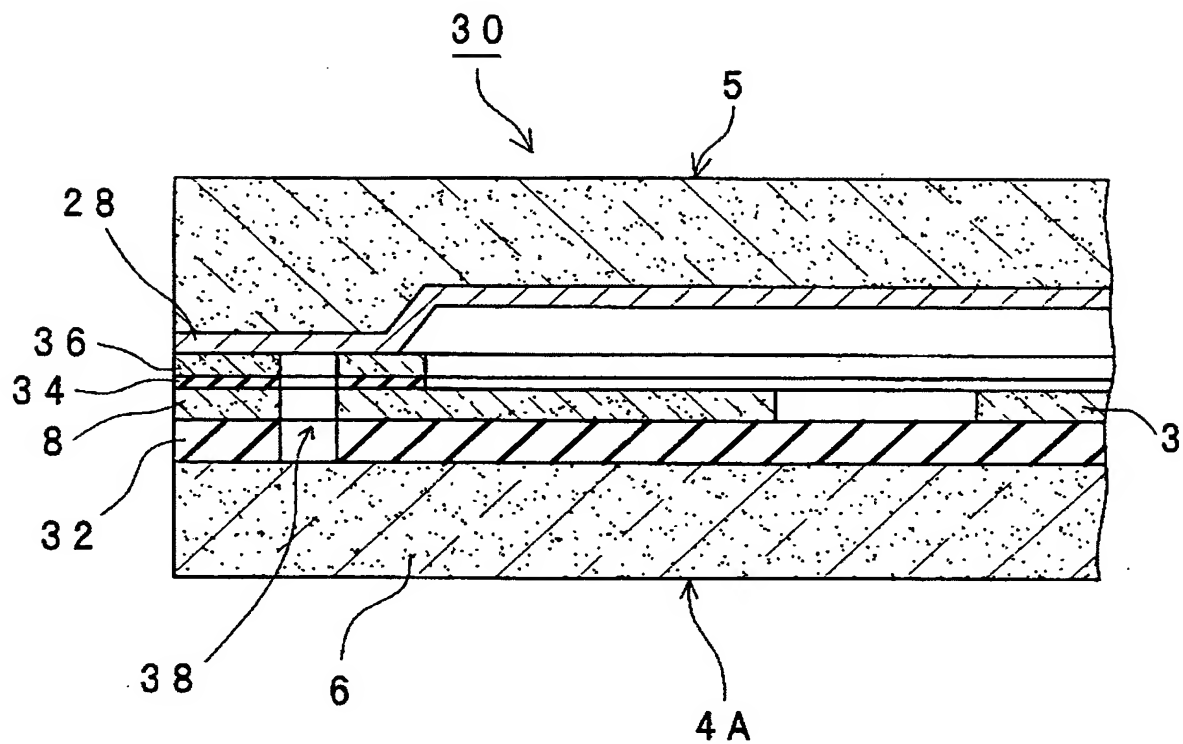
【図 2】



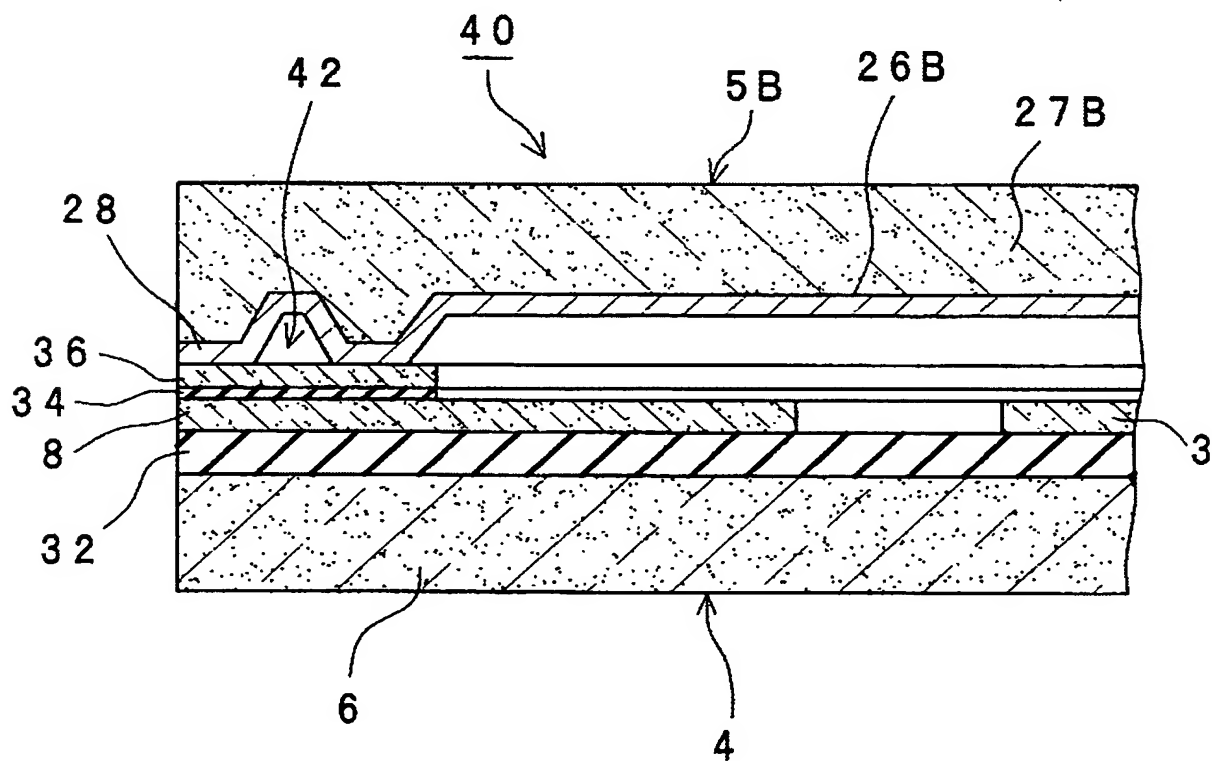
【図 3】



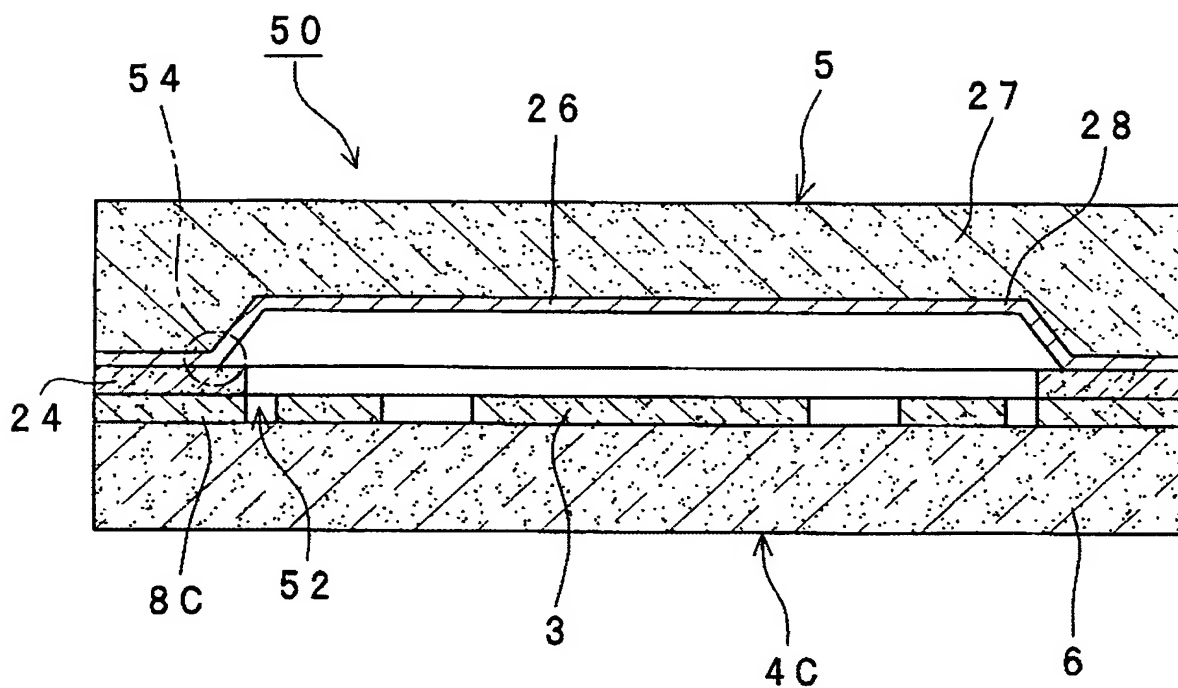
【図 4】



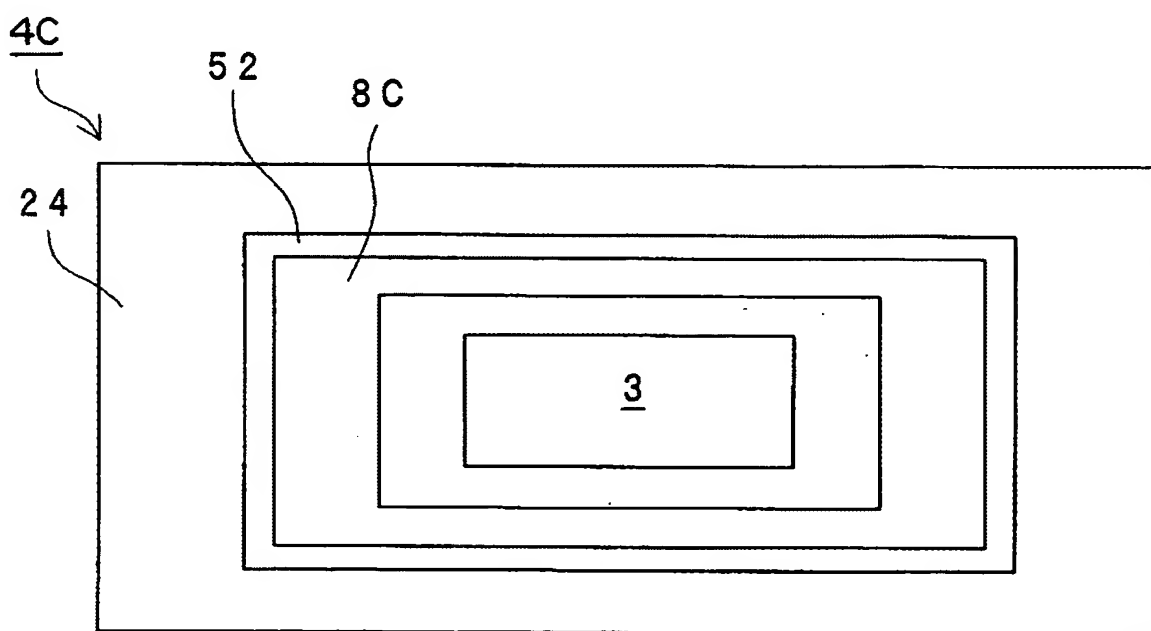
【図 5】



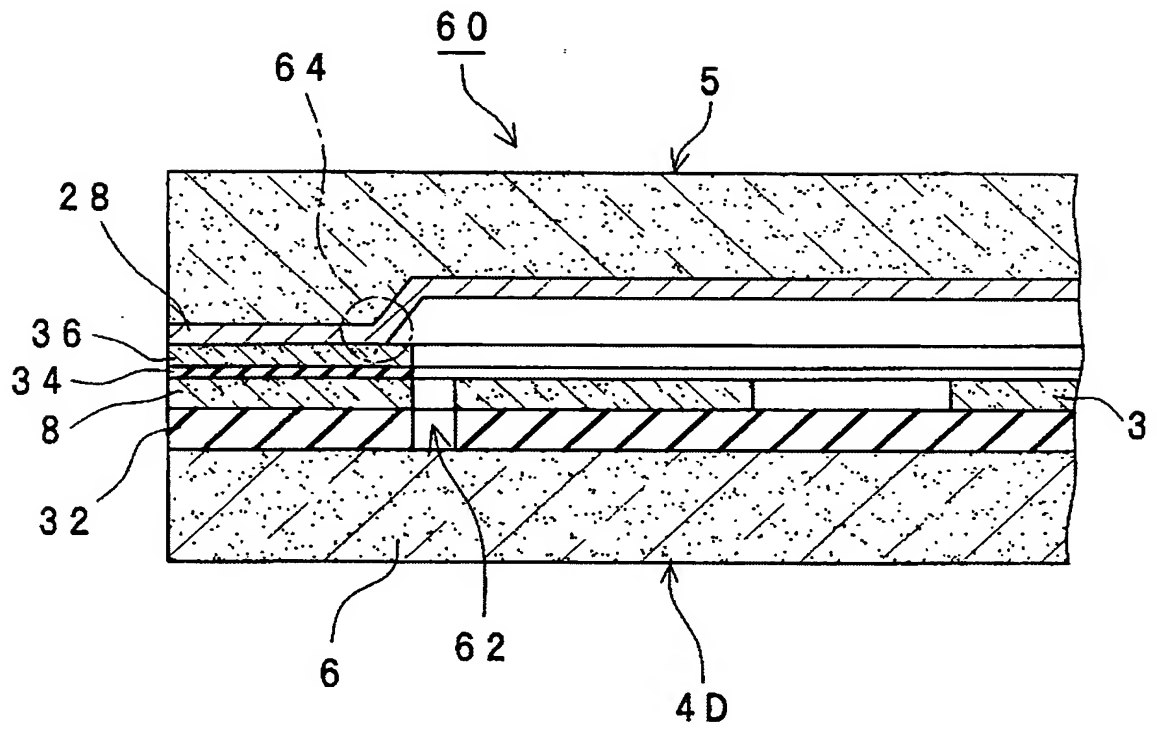
【図 6】



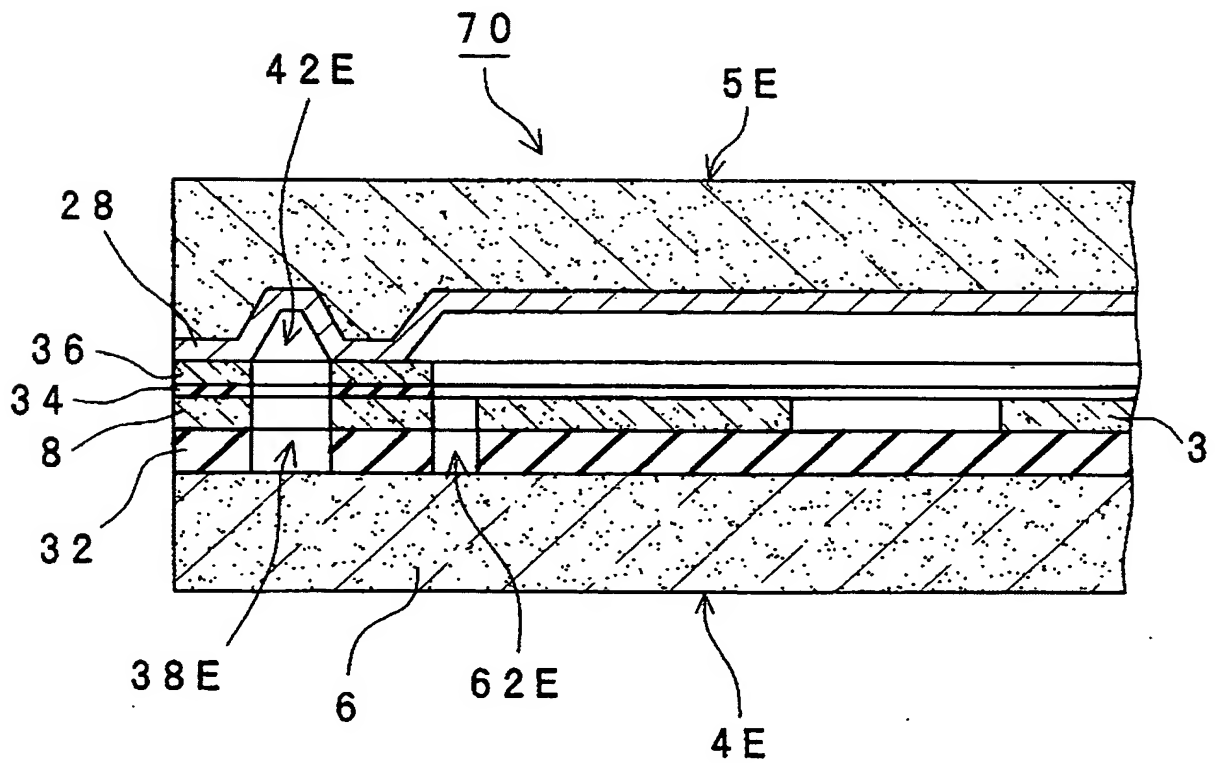
【図 7】



【図 8】



【図 9】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 外力によるクラックの伝播を防止しつつ加速度センサの半導体基板主面方向に関する寸法の小型化を図る。

【解決手段】 加速度センサ 2 は、半導体基板 6 と、半導体基板 6 上に配設された、加速度センサ素子 3 および該センサ素子 3 を囲む枠部 8 と、枠部 8 上に配設された中間層 34、36 と、中間層 34、36 と接合され、これにより加速度センサ素子 3 を封止するキャップ部 5 とを備える。枠部 8 および中間層 34、36 にはそれぞれ、半導体基板 6 主面方向に関し略同一の位置に枠状の溝が設けられ、全体として枠状溝 38 が形成されている。

【選択図】 図 4



特願 2 0 0 3 - 3 1 1 0 6 6

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[ 0 0 0 0 0 6 0 1 3 ]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 2 4 日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都千代田区丸の内 2 丁目 2 番 3 号

氏 名

三菱電機株式会社